多孔質シリカ担持 Ni 試料の水素吸着能に関する検討

恩田紘樹・熊澤直人*・塚本さゆり・徳田敬二*・鈴木 崇**

Investigation of hydrogen adsorption capacity regarding nickel metals supported on porous silica Koki ONDA, Naoto KUMAZAWA, Sayuri TSUKAMOTO, Keiji TOKUDA and Takashi SUZUKI

多孔質化 SiO₂ に Ni を担持した試料(以下、Ni/pSiO₂)の低温(-196 ℃)および高温(50 ℃)における水素吸着量を評価した。その結果、低温における Ni/pSiO₂ への水素吸着量は、 SiO₂ 担持 Ni 試料(以下、Ni/SiO₂)への水素吸着量と比較して大きな違いが見られなかっ たのに対し、高温では 1.2 倍に増大した。また、Ni/pSiO₂ に Cu を添加したところ、化学 吸着した水素の吸着量はほとんど変化させずに脱離温度が 115.2 ℃から 99.6 ℃に低下し た。以上のことから、水素貯蔵の観点から吸着だけでなく脱着しやすさも重要であり、 Cu の添加によって水素吸着量の減少を抑制しながら脱着温度を低下できたことの技術的 な意義は大きいと考えられた。

キーワード:水素、物理吸着、化学吸着、ニッケル、銅、シリカ

Adsorption amount of hydrogen on Ni supported on porous silica (Ni/pSiO₂) was evaluated at low temperature around -196 °C and at high temperature around 50 °C. The adsorption amount of hydrogen on the Ni/pSiO₂ specimen at low temperature was almost the analogous with that of Ni/SiO₂ specimen. In contrast to these, the adsorption amount observed at high temperature was increased 1.2 fold as much as that on non porous Ni/SiO₂ specimen. In addition, when temperature programmed desorption(TPD) of hydrogen was performed on Ni/pSiO₂ containing 1wt.% of Cu specimen, desorption peak temperature of chemisorbed hydrogen was shifted from 115.2 °C to 99.6 °C. From these results, it was worthy to mention that the absorbent should have large capacity of desorption as well as that of adsorption for hydrogen storage and carriage system. Finally, it might be important from engineering viewpoint that declining desorption temperature of hydrogen was achieved with small decrease of hydrogen adsorption by adding copper to Ni/SiO₂ specimen.

Keywords: hydrogen, physisorption, chemisorption, nickel, copper, porous silica

1 はじめに

水素は燃焼時に水のみを生成し、化石燃料のように二酸化炭素を排出しないことからクリーン燃料ガスとして着目¹⁾され、エネファーム²⁾や燃料電池車³⁾のように水素を燃料として利用する燃料電池の実用化が進んでいる。また、水素ステーションなど

の社会インフラの整備も進んでおり、今後 ますます水素の需要は高まると予想されて いる。水素の製造技術や輸送技術は大手石 油会社やガス会社を中心に既にほぼ確立さ れている⁴⁾。しかし、水素は現行燃料(天 然ガス、ガソリン、軽油等)と比較して体 積エネルギー密度が低く、貯蔵効率が低い という課題がある。このため、水素吸着材 を用いて水素を貯蔵できれば、より安全か つ低コストに水素貯蔵量を増加できる可能 性がある。水素吸着材には、水素を多く吸 着でき、かつ容易に水素を脱離できること が求められる。

これまでに我々は、水素の化学吸着能に 優れた Ni を高比表面積 SiO2(以下、 SiO₂)に担持することにより、物理吸着だ けでなく、Ni への化学吸着により水素を 貯蔵する水素貯蔵材の開発に取り組んでき た の。本報告では、さらに、Ni の分散性 向上による化学吸着水素量の増大を目的に、 図1に示す様に SiO₂に易燃性有機化合物 を混錬して打錠成形した後、焼成すること で多孔質化した SiO₂(以下、pSiO₂)に Ni を担持し、その水素吸着能を評価した。さ らに Ni/pSiO2 に対する化学吸着水素の吸 着力を適度に低減して脱離温度を下げ、水 素の脱離を容易にすることを目的に、第3 成分として Cu を添加し、脱離ピーク温度 変化について検討したので報告する。

2. 実験

2. 1 SiO₂ 担持 Ni 試料の調製

SiO₂(Silica Gel60、比表面積 410m²/g、 Merck 製)を電気炉(FO-300、ヤマト科学 製)で 500 ℃で 2 時間焼成した。仕上がり の試料重量基準で Ni が 10wt%含有される よう、硝酸ニッケル六水和物(Ni(NO₃)₂・ 6H₂O、試薬特級、和光純薬製)にイオン交 換水を溶解させた。これにイオン交換水を 加え、飽和吸水量の約 1.2 倍容の硝酸ニッ ケル水溶液を調製した。この水溶液を予め 焼成した所定量の SiO2 に含浸させ、1 時 間静置した。得られたスラリーをロータリ ーエバポレーターに移し、50 ℃に加温し ながらアスピレーターで減圧乾燥後、石英 製炉心管に移し、横型管状電気炉(KTF-30N、光洋製)で空気を約 200ml/min で通気 しながら 500 ℃で 2 時間焼成し、SiO2 担 持 Ni 試料(Ni/SiO₂)の前駆体を得た。

2. 2 pSi02 担持高分散型金属試料の調製

SiO2 に対し、易燃性有機化合物である 酒石酸を 2wt%となるように混合し、自動



図 1 pSi02 調製の模式図

乳鉢(ANM1000、日陶科学製)を用いて乳棒 を 100rpm、乳鉢を 6rpm で回転しながら 1 時間混合した。その後、手動油圧ポンプ (P-16B、理研精機製)を用い、打錠圧力 40MPa で直径 15mm の打錠成形体 SiO₂を 得た。さらに 500℃で 1 時間焼成して酒石 酸を熱分解除去した後、乳鉢で破砕して 250 メッシュのふるいにかけ、これを pSiO2 担体とした。その後、§2.1 に記載 した方法と同様の方法により、試料重量基 準で Ni が 10wt%含有されるように担持し た。銅添加試料については、所定量の硝酸 銅三水和物(Cu(NO₃)₂·3H₂O、試薬特級、 和光純薬製)を試料重量基準で Cu が 1wt% 含有されるように添加した。このようにし て pSiO₂ 担持 Ni 試料(以下、Ni/pSiO₂)およ び pSiO₂ 担持 Cu-Ni 試料(以下、Cu-Ni/pSiO₂)の前駆体を得た。

2. 3 比表面積測定

高分散型金属含有試料の比表面積測定に は高速比表面積測定装置(AUTOSORB-1、 ユアサアイオニクス製)を用い、吸着ガス を窒素として BET3 点法 ⁵⁾により測定した。

2. 4 水素昇温脱離(H₂-TPD)

触媒物性試験装置(BEL-CAT、日本ベル 製)を用い、水素を流量 50ml/min で流通し ながら 500 ℃で 1 時間、試料を水素還元 した後、50 ℃でアルゴンと水素の混合ガ ス(アルゴン/水素=7/3)を流量 50ml/min で 流通しながら水素を飽和吸着させた。その 後、アルゴンを流量 50ml/min で流通しな がら 10 ℃/min で 500 ℃まで昇温し、試 料からの水素脱離温度を測定した。



図2 閉鎖循環系反応装置の模式図

2.5 試料の活性化処理

高分散型金属含有試料前駆体あるいは pSiO₂ 担持 Ni 試料の前駆体を、図2に示 す体積既知の閉鎖循環系装置の固定床に 0.5g 設置し、500 ℃で1 時間真空加熱排 気した。閉鎖循環系装置内の圧力が 250Torr(33.3kPa)に到るまで水素を導入し、 また、トラップを液体窒素で冷却して還元 時に生成する水を除去し、500 ℃で1時間 還元した後、固定床の温度を 500℃に保持 しながら真空排気した。

2. 6 水素吸着量測定

高分散型金属含有試料の活性化処理後、 固定床温度を 500 ℃に保持しながら閉鎖 循環系装置内の圧力が 380Torr(50.5kPa)に 到るまで水素を導入した。その後、固定床 温度を 50 ℃まで降温し、その際の系内圧 力の低下量に基づいて 50℃時点における 系内の水素減少量を算出した。この水素減 少量から、固定床に試料を設置せずに同様 の操作を行った場合の系内における水素減 少量を差し引き、これを高温(50℃)時の 試料への水素吸着量(高温吸着量)とした。 さらに固定床を液体窒素に 1 時間浸して 50℃から-196℃にまで降温した際の系内圧 力の低下量に基づき、-196 ℃時点におけ る系内の水素減少量を算出した。この水素 減少量から、固定床に試料を設置せずに同 様の操作を行った場合における系内の水素



図3 NI/SIO2およびNI/多れ貨 SiO21g 当たりの水素吸着量

減少量を差し引き、これを低温(-196℃) 時の試料への水素吸着量(低温吸着量)と した。さらに高温吸着量および低温吸着量 の和を総吸着量とした。

3. 結果および考察

3. 1 Ni/pSiO2の水素吸着能

前報にて、WII族金属であるNi、Coおよび Feのうち、Niが最も水素吸着能が高いこと を示した^の。そこで、Niの分散性向上によ る化学吸着水素量増大を目的に、§2.2に記 載の方法でNi/pSiO₂を調製した。

図3に、Ni/SiO₂およびNi/pSiO₂1g当たり の総吸着量、低温吸着量および高温吸着量 を示す。Ni/SiO₂の総吸着量、低温吸着量 および高温吸着量はそれぞれ1.003mmol/g、 0.769mmol/gおよび0.234mmol/mlだったの に対し、Ni/pSiO₂ではそれぞれ1.062mmol/g、 0.782mmol/gおよび0.280mmol/gだった。ま た、Ni/SiO₂およびNi/pSiO₂についてH₂-TPD 測定を行ったところ、高温吸着水素の脱離 ピーク温度はそれぞれ128.0℃および115.2 ℃だった。なお、Ni/SiO₂およびNi/pSiO₂の 比表面積はそれぞれ196m²/gおよび198m²/g だった。

低温吸着量はNi/pSiO₂とNi/SiO₂とでほと んど差が見られなかった。これは低温吸着 水素が主に吸着量が試料の比表面積に依存 する物理吸着水素である^のためと考えられ

	水素吸着量(mmol/g)			高温吸着水素の
	低温吸着量	高温吸着量	総吸着量	脱離ピーク温度(℃)
Ni/pSiO ₂	0.782	0.280	1.062	115.2
Cu-Ni/pSiO ₂	0.783	0.253	1.036	99.6

表 1 Cu-Ni/pSiO₂への水素吸着量および高温吸着水素の脱離ピーク温度

た。これに対し、高温吸着量は $Ni/pSiO_2$ の 方が Ni/SiO_2 と比較して多かった。これは、 $Ni/pSiO_2$ では Ni/SiO_2 よりもNiが高分散に担 持され、水素の化学吸着サイトが増加した ためと考えられた。

一方、Ni/pSiO₂における高温吸着水素の 脱離ピーク温度はNi/SiO₂と比較して12.8C低くなった。これは、Niの分散性向上に伴 い、酸化状態が高くなり、化学吸着水素の 吸着力が弱くなったためと考えられた。

3. 2 Cu-Ni/pSiO2の水素吸着能

水素貯蔵の観点から、水素吸着能が高い だけでなく、容易に脱着できることも重要 である。そこで、Niの酸化状態を高める ことで化学吸着水素の吸着力を低減し、脱 離温度を下げることを目的に、Niよりも 電気陰性度の大きい Cu を添加した Cu-Ni/pSiO₂を§2.2 に記載の方法で調製した。

表1に、Ni/pSiO₂ および Cu-Ni/pSiO₂1g 当たりの総吸着量、低温吸着量、高温吸 着量および高温吸着水素の脱離ピーク温 度を示す。

Ni/pSiO₂の総吸着量、低温吸着量および 高温吸着量はそれぞれ前述の通り 1.062mmol/g、 0.782mmol/g および 0.280mmol/g だったのに対し、Cu-Ni/pSiO₂ では、それぞれ 1.036mmol/g、 0.783mmol/g および 0.253mmol/g だった。 また、Cu-Ni/pSiO₂の比表面積は 197m²/g だった。さらに H₂-TPD による高温吸着 水素の脱離ピーク温度は Ni/pSiO₂ で 115.2 °Cだったのに対し、Cu-Ni/pSiO₂ では 99.6 °Cだった。

Ni/pSiO₂ と Cu-Ni/pSiO₂ とで低温吸着量 に違いはほとんど見られなかったのは、両 試料の比表面積が同程度であり、物理吸着 水素量はほとんど変わらなかったためと考 えられた。これに対し、Cu-Ni/pSiO₂の高 温吸着量は Ni/pSiO₂ のそれの 0.90 倍だった。これは、Cu-Ni/pSiO₂では一部 Ni が水素の化学吸着能の低い ⁸⁾Cu に被覆されたためと考えられた。

Cu-Ni/pSiO₂ における高温吸着水素の脱 離ピーク温度は Ni/pSiO₂ のそれと比較し て 15.6℃低下した。これは、Cu 添加によ り Ni の酸化状態が高くなり、水素の化学 吸着力が弱くなったためと考えられた。こ のように、Cu 添加により脱離ピーク温度 を低下できたことから、TSA(Temperature swing adosorption)での温度変動幅を小さく することが可能となり、プロセス設計上の メリットとなると考えられた。

4. まとめ

① SiO₂ の多孔質化により高温吸着量が増加と高温吸着水素の脱離ピーク温度低下が見られた。これは、Ni の分散性向上により水素の化学吸着サイトが増加し、さらにNi の酸化状態が高くなり、化学吸着水素の吸着力が弱くなったためと考えられた。 ② Ni/pSiO₂ に Cu を添加することで高温吸着量は減少した。これは、Cu により Ni の一部が被覆されたためと考えられた。 ③ Ni/pSiO₂ に Cu を添加することで高温吸着水素の脱離ピーク温度が低下した。これ は Ni の酸化状態が高くなり、化学吸着水素の吸着力が弱くなったためと考えられた。

文献

NEDO,水素エネルギー白書 2014, pp4
2)堀田,表面科学,34, 154(2013).
3)大仲,水素エネルギーシステム, 34, 10(2009).

4) 岡田, 安井, 化学工学, **77**, 46(2013).

5)H. C. Suciu, L. Gagea and M. Mocean, *Chem. Eng. Sci.*, **61**, 7831(2006).

6)恩田, 熊澤, 塚本, 徳田, 鈴木, 群馬産業技術センター研究報告(平成 27 年度),1(2015).

7) 化学便覧基礎編改訂 4 版,日本化学会 編,丸善(1993)

8)P. Siegbahn, M. Blomberg, I. Panas and U. Wahgren, *Theo. Chim. Acta*, **75**, 143 (1989).